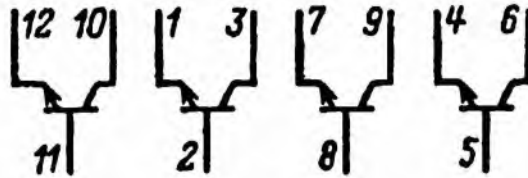


КР198НТ3А, КР198НТ3Б

Микросхемы представляют собой матрицу *n-p-n* транзисторов. Содержат 4 интегральных элемента. Корпус типа 201.14-1, масса не более 1 г.



Электрическая схема КР198НТ3

Назначение выводов: 1 — эмиттер VT2; 2 — база VT2; 3 — коллектор VT2; 4 — эмиттер VT4; 5 — база VT4; 6 — коллектор VT5; 7 — эмиттер VT3; 8 — база VT3; 9 — коллектор VT3; 10 — коллектор VT1; 11 — база VT1; 12 — эмиттер VT1; 13, 14 — свободные.

Электрические параметры

Напряжение насыщения база — эмиттер	≤ 1 В
Напряжение насыщения коллектор — эмиттер	≤ 0,7 В
Обратный ток коллектора	≤ 40 нА
Статический коэффициент передачи тока:	
КР198НТ3А	20...125
КР198НТ3Б	60...250

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Напряжение коллектор — база	20 В
Напряжение эмиттер — база	5 В
Ток коллектора	10 мА
Рассеиваемая мощность одним транзистором	20 мВт
Температура окружающей среды	-45...+85 °С